Ver 1.0

CD4093

■ 产品简介

CD4093 是一款采用先进 CMOS 技术设计的具有施密特输入特性的 2 输入与非门。它有较好的抗干扰能力和较强的驱动能力。

■ 产品特点

● 低输入电流: I_{IN}≤1.2uA, @V_{IN}=VDD=18V, Ta=25℃

● 低静态功耗: IDD≤1. 2uA, @VDD=18V, Ta=25℃

● 宽工作电压范围: 3.0V to 18V

● 封装形式: DIP14 、SOP14

■ 产品用途

● 电子开关

● 信号振荡发生器

● 工控应用

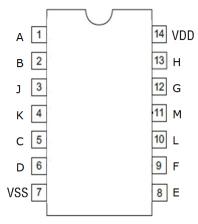
● 其它应用领域

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号	管脚	管脚序号	管脚
DIP14/SOP14	定义	DIP14/S0P14	定义
1	A	14	VDD
2	В	13	Н
3	J	12	G
4	K	11	M
5	С	10	L
6	D	9	F
7	VSS	8	Е

注: CDxxxxD 表示 DIP16 封装, CDxxxxS 表示 SOP16

DIP14/S0P14



■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
电源电压	V _{DD}	-0.5-20	V
输入电压	V _{IN}	-0. 5+VSS-V _{DD} +0. 5V	V
功耗	P_{D}	500	mW
工作温度	Та	0-70	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
存储温度	Ts	-65-150	$^{\circ}$
引脚焊接温度	Tw	260, 10s	${\mathbb C}$

注: 极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤,同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

Ver 1.0

■ 原理逻辑图

$\frac{A}{B} = J$

注: 1/4组

■ 真值表

INP	OUTPUTS		
B/D/F/H	A/C/E/G	J/K/L/M	
L	L	Н	
L	Н	Н	
Н	L	Н	
Н	Н	L	

注: 1、L 为低电平, H 为高电平; 2、ĀB=J; CD=K; EF=L; HG=M

■ 推荐工作条件

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	3		15	V
输入输出电压	V _{IN} , Vout	0		VDD	V
工作温度	TA	0		60	${\mathbb C}$

■ 电学特性

直流电学特性: (T_A=25℃ 除非特别指定)

符号	项目	测试条件	VDD (V)	最小值	典型值	最大值	单位
.,	施密特输入上电		5	_	3. 2	4	V
V _P	压		15	_	8.8	9.5	V
VN	施密特输入下限		5	1.0	1.8		V
VN	电压		15	4.0	5. 4	=	V
VH	施密特回滞电压		5	_	1.4	_	V
VH	宽度 V _P -V _N		15	_	3.4	_	V
			5	4.95	_	_	V
Vон	高电平输出电压	Ιουτ <1uA	10	9.95	_	_	V
			15	14. 95	_	_	V
		I _{OUT} <1uA	5	_	0	0.05	V
Vol	Vol 低电平输出电压		10	_	0	0.05	V
			15	_	0	0.05	V
IIN	输入电流	$V_{IN} = VDD$ or VSS	18	_	0.01	1.2	uA
Іон 高电平输出电流	Vo= 4.6V	5	_	-1.8	-	mA	
	高电平输出电流	Vo= 9.5V	10	_	-3.7	_	mA
		Vo= 13.5V	15	_	-13.7	_	mA
		Vo= 0.4V	5	_	3.6	_	mA
IoL	低电平输出电流	Vo= 0.5V	10	_	8.6	-	mA
		Vo= 1.5V	15	_	32. 5	_	mA
I_{DD}	工作电流	V _{IN} =VDD or VSS	18	_	0.01	1.2	uA

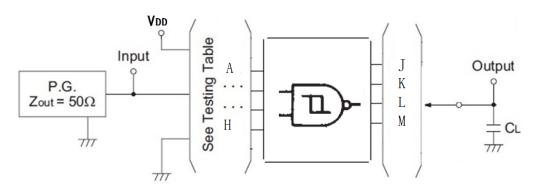


交流电学特性: Ta=25℃,见测试方法。

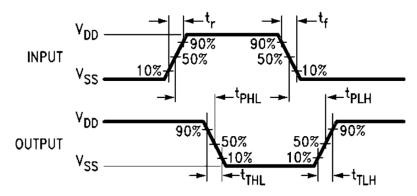
项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	t _{PHL}	VDD=5V CL=51pF	-	130	П	ns
最大传输延迟时间	t _{PLH}	VDD-3V CL-31pr	-	85	ı	ns
A or B to J C or D to K	t_{PHL}	VDD=10V CL=51pF	_	70	_	ns
E or F to L	t_{PLH}	VDD-10V CL-51pi	_	50	_	ns
G or H to M	t _{PHL}	VDD=15V CL=51pF	_	60	_	ns
	t _{PLH}		_	35	_	ns
输出最大上升、下 降沿延迟时间	t_THL	VDD=5V CL=51pF	_	90	_	ns
	t_TLH	VDD-3V CL-31pr	_	70	_	ns
	tтнL	VDD=10V CL=51pF	_	50	_	ns
	tтьн	VDD-10V CL-51pi	_	35	_	ns
	t_THL	VDD=15V CL=51pF	_	40	_	ns
	tтьн	νυυ-19ν CL-91bi.	=	25	=	ns

■ 测试方法

1、测试接线图



2、波形测量示意图



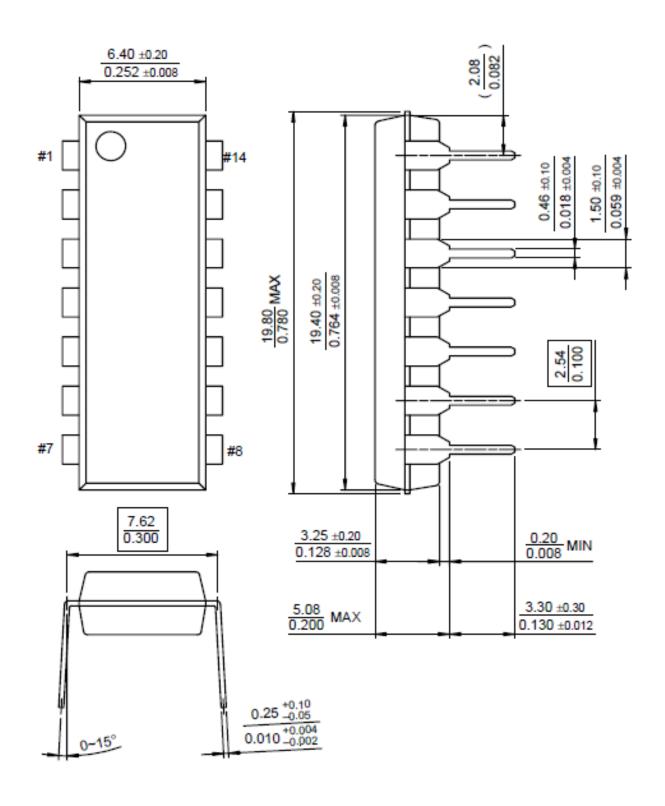
- 注: 1、See Testing Table 指交流电学特性表中相应测试项目;
 - 2、CL 电容为外接贴片电容(0603),靠近输出管脚接入,电容地靠近芯片 VSS;
 - 3、Input:端口输入电平,f=1MHz,D=50%方波,tr=tf≤20ns;
 - 4、Output: Y端输出测试。



■ 封装信息

Ver 1.0 单位:毫米 / 英寸

DIP14



S0P14

Ver 1.0

